Том 229

1972

## О ЛИНЕАРИЗАЦИИ СТАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛОМЕТРА

Л. Я. ЗИННЕР, А. А. КОЗЛОВ

(Представлена научным семинаром кафедр электрических машин и общей электротехники)

Для контроля качества поверхности коллекторов электрических машин все большее применение получают профилометры, использующие принцип частотной или амплитудной модуляции высокочастотного сигнала генератора в функции расстояния между датчиком и поверхностью коллектора. В качестве измерительных элементов в этих приборах используются емкостные или индуктивные датчики [1, 2]. Общим недостатком таких приборов является нелинейность их статической характеристики, обусловленная как нелинейностью характеристики преобразования датчиков, так и способом подключения их к измерительной схеме. Если в статическом режиме измерений эту нелинейность легко учесть, то при исследовании коллектора в режиме вращения возникает погрешность измерений, величина которой определяется видом нелинейности и динамическим диапазоном измерений. С целью уменьшения этой погрешности обычно выбирают наиболее линейный участок статической характеристики прибора, сужая тем самым интервал измерений. Динамический диапазон измерений может оказаться в этом случае меньше заданного, и некоторые авторы рекомендуют применять набор датчиков, имеющих различную длину участка характеристики преобразования, на котором датчик имеет постоянную чувствительность [3]. Поскольку к датчику предъявляется ряд противоречивых требований, к числу которых относится обеспечение достаточной динамической разрешающей способности и чувствительности, то датчик, удовлетворяющий первому требованию, может иметь в интервале измерений значительную нелинейность, которая приводит к недопустимой погрешности измерений. Найдем аналитическое выражение этой погрешности.

Пусть характеристика преобразования датчика имеет вид (рис. 1, a): U = f(d)

U — сигнал на выходе датчика;

d — расстояние между датчиком и поверхностью коллектора.

Обозначим перепад между двумя соседними ламелями при малой величине зазора  $h_1$  и при большой  $h_2$  (рис. 1, б). Допустим, что  $h_1 = h_2 = h$ . При изменении зазора на величину h на линейном участке характеристики сигнал на выходе прибора изменится

на величину:

 $\Delta U = K \cdot h$ 

где K — крутизна линейного участка статической характеристики прибора.

Если функция U = f(d) имеет производную в заданном интервале [O,  $d_{\max}$ ] (что практически всегда выполняется), то справедлива формула Лагранжа:

$$\frac{f(d_0 + h) - f(d_0)}{h} = f'(\xi)$$

$$d_0 < \xi < d_0 + h$$

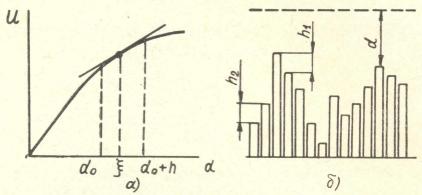


Рис. 1. а — кривая U=f(d); б — профиль участка коллектора

Можно записать также:

$$\frac{f(d_0+h)-f(d_0)}{K}=h-\Delta h,$$

 $\Delta h$  — погрешность измерения h за счет нелинейности. Отсюда

$$\Delta h = h \left[ 1 - \frac{f'(\xi)}{K} \right].$$

В этой формуле неизвестна величина  $\xi$ . Запишем:  $\xi = d_0 + \Theta \cdot h$ , где  $0 < \Theta < 1$ . Если взять  $\Theta = \frac{1}{2}$ , то  $\xi = d_0 + \frac{h}{2}$ , и погрешность в определении  $\Delta h$  составит в худшем случае 0,1%. Следовательно, можно записать:

$$\Delta h = h \cdot \left[ 1 - \frac{f'\left(d_0 + \frac{h}{2}\right)}{K} \right].$$

При неизменном K погрешность  $\Delta h$  пропорциональна измеряемому перепаду h и уменьшается при  $f'(d_0 + \frac{h}{2}) \to K$ . Например, для функции

U = ln(d+1) в точке  $d_0$ , где нелинейность составляет 5%, погрешность в измерении перепада в 10 микрон достигает 20%. Вследствие этого возникает потребность в разработке устройств, позволяющих скорректировать нелинейность статической характеристики профилометра с целью расширения динамического диапазона измерений при неизменной разрешающей способности. Особенно остро она чувствуется при разработке профилометров для контроля поверхности коллекторов микромашин, у которых ширина ламелей достигает малых величин.

Локализация поля излучения датчиков в узкой зоне контроля, осуществляемая конструктивными мерами, позволяет обеспечить высокую динамическую разрешающую способность, но, как правило, приводит к тому, что характеристика преобразования оказывается существенно нелинейной.

При амплитудной модуляции в качестве корректирующих устройств применяются различного рода функциональные преобразователи, амплитудная характеристика которых подобрана таким образом, чтобы общая характеристика прибора оказалась линейной. Выбор типа такого преобразователя и способ его включения в схему определяется рядом требований, к числу которых относятся: точность воспроизведения заданной нелинейности; стабильность корректора во времени и с температурой; отсутствие частотных и фазовых искажений; простота и надежность; безынерционность; достаточный коэффициент передачи и другие.

В приборах с частотной модуляцией при построении схем коррек-

торов возникают значительные трудности.

Разнообразие характеристик датчиков не позволяет применять известные нелинейные элементы непосредственно в качестве корректоров, так как набор имеющихся нелинейных характеристик весьма ограничен. Кроме того, стабильность этих элементов часто оказывается недостаточной для реализации заданной характеристики с высокой степенью точности. Наиболее универсальными являются диодные и транзисторные корректоры. При проектировании таких устройств наиболее эффективно применение кусочно-линейной аппроксимации заданной функции с последующим воспроизведением аппроксимирующей зависимости в схемах на диодах или транзисторах, в которых последние выполняют роль бесконтактных переключателей. При этом в зависимости от способа задания функции аппроксимация рассчитывается аналитически или графически с заданной точностью.

Корректор может включаться на выходе прибора или в цепь обратной связи, которая в этом случае становится нелинейной. Включение корректора на выходе усилителя позволяет использовать его одновременно в качестве детектора. Недостатком такого способа является то, что необходимо увеличивать коэффициент усиления схемы, поскольку диодные корректоры имеют низкий коэффициент передачи. Включение корректора в цепь НОС нецелесообразно, поскольку на рабочих частотах порядка 1—10 Мгц полупроводниковые элементы имеют значительные реактивные проводимости, что приводит к фазовым и частотным искажениям в цепи НОС. Для целей коррекции выгоднее использовать цепь автоматической регулировки усиления (АРУ) с нелинейным детектором которая охватывает усилитель профилометра (рис. 2).

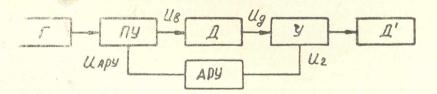


Рис. 2. Схема профилометра с нелинейной АРУ. Г — генератор; ПУ — предварительный усилитель; Д — датчик; Д' — детектор; У — усилитель

Допустим, что сигнал на выходе датчика пропорционален напряжению возбуждения и определяется выражением:  $U_{\sigma} = U_{b} \cdot F(d)$ .

Для полной линеаризации необходимо регулировать коэффициент усиления предварительного усилителя так, чтобы сигнал на выходе датчика был пропорционален зазору:

$$U_{\sigma} = K \cdot d$$

где K — коэффициент пропорциональности.

$$K_{\Pi Y} = \frac{K}{f(d)}$$
, (1) где  $f(d) = \frac{F(d)}{d}$ .

Этот коэффициент, в свою очередь, зависит от напряжения управления  $U_{\mathrm{APY}}$ :

 $K_{\Pi Y} = \psi \left( U_{APY} \right) \tag{2}$ 

Приравнивая (1) и (2), получаем неявное уравнение для определения функции  $U_{\rm APY} = \varphi(d)$ . Эта зависимость реализуется нелинейным детектором в цепи APУ.

Поскольку в литературе отсутствует методика расчета цепей АРУ с целью линеаризации статистических характеристик приборов, попытаемся восполнить этот пробел на примере конкретной схемы.

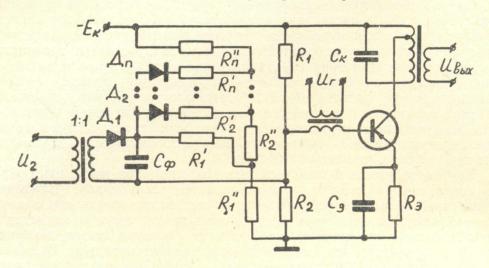


Рис. 3. Принципиальная схема регулируемого каскада с цепью АРУ.

В качестве регулируемого каскада предварительного усилителя использован резонансный усилитель на транзисторе, коэффициент усиления которого меняется путем изменения режима по постоянному току. В качестве параметра регулирования используется ток коллектора  $i_k$ . Расчет схемы основан на представлении транзистора в виде 4-полюсника, описываемого системой малосигнальных y-параметров. В схемах профилометров применяют обычно высокочастотные транзисторы, поэтому рабочая частота оказывается гораздо меньше той величины, где начинают сказыватья реактивные составляющие проводимостей. Вследствие этого комплексностью y-параметров можно пренебречь, полагая:  $y_{11} = g_{11}$ ;  $y_{21} = g_{21}$ ;  $y_{22} = g_{22}$ . Проводимость  $y_{12}$  приравниваем нулю, считая, что усилитель нейтрализован.

Известно, что коэффициент усиления по напряжению каскада с одиночным контуром

$$K = \frac{m_1 \, m_2}{g_{\kappa}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{g_{BH}}{g_{\kappa}}} \,, \tag{3}$$

где  $g_{\kappa} = \frac{1}{R_{\kappa}} - \text{собственная резонансная проводимость контура;}$ 

 $g_{\text{вн}} = m_1^2 g_{\text{н}} + m_2^2 g_{22}$  — вносимая проводимость;

 $m_1$  и  $m_2$  — коэффициенты включения, определяемые элементами связи и схемой включения транзистора в контур [4].

g<sub>н</sub> — проводимость нагрузки.

Зависимость проводимости  $g_{21}$  от коллекторного тока с достаточной для инженерного расчета точностью можно представить выражением [5]:

$$g_{21} = \frac{ai_{K}}{1 + abi_{K}},$$

$$a = \frac{q}{kT},$$
(4)

где q — заряд электрона;

k — постоянная Больцмана;

*T* — температура по Кельвину;

Коэффициент b определяется как отношение распределенного сопротивления базы  $r_6$  к среднему значению статического коэффициента усиления по току  $h_{21}$ .

Зависимость  $g_{22}(i_{\kappa})$  выражается соотношением [6]

$$g_{22} = C \cdot i_{\kappa}, \tag{5}$$

C — коэффициент, зависящий от граничной частоты и имеющий размерность  $m\kappa mo/ma$ .

 $C \approx \frac{h_{226}}{(1 - h_{216}) \cdot i_{\scriptscriptstyle \mathrm{SH}}},$  [7]

 $h_{215}$  — коэффициент усиления по току в схеме с общей базой.

С целью эффективного регулирования коэффициентом усиления каскада ток  $i_{\kappa}$  необходимо изменять в широких пределах. Однако его максимальное и минимальное значения ограничены рядом условий. Так,  $i_{\kappa max}$  ограничен величиной мощности, рассеиваемой на коллекторе транзистора. Даже незначительный нагрев транзистора за счет действия  $i_{\kappa}$  может вызвать нестабильность APV. При больших  $i_{\kappa}$  увеличивается мощность, потребляемая каскадом от нелинейного детектора, что требует дополнительного усиления в цепи APV. При больших токах коллектора лучше регулируются те транзисторы, которые имеют малую величину b.

Величина  $i_{\rm kmin}$  выбирается с учетом требования минимальных нелинейных искажений, которые определяются в основном нелинейностью входных характеристик транзистора и амплитудой высокочастотного напряжения  $U_{\bf r}$ . С уменьшением  $i_{\rm k}$  возрастает влияние неуправляемого тока коллектора  $I_{\rm ko}$  на работу схемы. При этом температурная ста-

бильность каскада значительно ухудшается.

Диапазон изменений тока  $i_{\kappa}$ , выбранный с учетом этих условий, реализуется изменением напряжения, поступающего с нелинейного детектора на вход транзистора. Положение рабочей точки в исходном режиме и ее стабилизация при изменении температуры, смене транзистора и т. д. осуществляется сопротивлениями  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_9$ , которые рассчитываются по известным формулам. При этом нестабильность положения рабочей точки можно характериозвать величиной [8].

$$\frac{\Delta i_{K}}{i_{K}} = \frac{R_{1} + R_{9} + \frac{R_{1} R_{9}}{R_{2}}}{h_{216} \cdot E_{K}} \cdot I_{K0}(0) \cdot e^{\tau t}; \tag{6}$$

t -- температура,

 $I_{\text{ко}}\left(O\right)$  — обратный ток коллекторного перехода при  $t=0^{\circ}\text{C}$ ,  $\gamma$  — температурный коэффициент.

Величину  $R_9$  необходимо выбирать несколько меньше, чем в обычных каскадах, так как при большой его величине эффективность цепи APУ уменьшается за счет действия ООС по току. В каскадах с APУ в работе [9] рекомендуется выбирать

 $\frac{\Delta i_{\kappa}}{i_{\kappa}} \approx \frac{\Delta i_{\vartheta}}{i_{\vartheta}} = 0.2 \div 0.4.$ 

Влияние управляющего сигнала на параметр регулирования оценивается коэффициентом управления:  $N=\frac{\Delta\,i_{\rm K}}{\Delta\,U_{\rm y}}$ . Для определения этой величины каскад представляется в виде совокупности 4-полюсников. Так, параметры 4-полюсника, эквивалентного транзистору и сопротивлению  $R_{\rm 1}$ , характеризуются матрицей:

$$[y] = \begin{bmatrix} y_{11} + \frac{1}{R_1} & y_{12} - \frac{1}{R_1} \\ y_{21} - \frac{1}{R_1} & y_{22} + \frac{1}{R_1} \end{bmatrix}.$$

Далее, переходя к z-параметрам, определяем матрицу 4-полюсника, производного от полученного с добавлением  $R_{\ni}$ .

$$[z] = \begin{bmatrix} y_{22} + \frac{1}{R_1} & -y_{12} + \frac{1}{R_1} \\ \frac{\Delta y}{\Delta y} + R_{\vartheta} & \frac{\Delta y}{\Delta y} + R_{\vartheta} \end{bmatrix}$$
$$-\frac{y_{21} + \frac{1}{R_1}}{\Delta y} + R_{\vartheta} & \frac{y_{11} + \frac{1}{R_1}}{\Delta y} + R_{\vartheta} \end{bmatrix}$$

тде  $\Delta y$  — определитель матрицы [y];  $\Delta z$  — определитель матрицы [z].

Опуская преобразования с участием промежуточной матрицы [a], получаем;

$$N = \frac{\Delta i_{\rm K}}{\Delta U_{\rm y}} \approx \frac{y_{21} - \frac{1}{R_1} - R_{\vartheta} \cdot \Delta y}{\left(1 + \frac{R_{\phi}}{R_2}\right) \cdot \Delta z \cdot \Delta y + R_{\phi} \left(y_{11} + \frac{1}{R_1} + R_{\vartheta} \cdot \Delta y\right)}.$$

 $R_{\Phi}$ — сопротивление фильтра нелинейного детектора. Подставляя определители и считая, что  $y_{21}\gg y_{11};\ y_{21}\gg y_{22};\ \frac{1}{R_1}\ll \frac{R_{\Theta}\cdot y_{21}}{R_1}$ , а также пренебрегая комплексностью у-параметров, после преобразований получаем:

$$N \approx \frac{g_{21} \left(1 - \frac{R_{\vartheta}}{R_{1}}\right)}{1 + R_{\vartheta} g_{21} + R_{\varphi} \left[g_{11} + \frac{1}{R_{2}} + \frac{R_{\vartheta} (R_{1} + R_{2})}{R_{1} R_{2}} \cdot g_{21}\right]}.$$
 (7)

В процессе регулирования ток коллектора изменяется по закону

$$i_{\rm K} = i_{\rm K \, min} + N \cdot K_{\rm \Pi} \cdot U_2, \tag{8}$$

где  $K_{\Pi}$  — коэффициент передачи нелинейного детектора,

$$K_{\Pi} = \frac{U_{y}}{U_{2}} \geqslant 0.$$

Напряжение  $U_y = K_{\pi} \cdot U_2 - U_{\text{CMI}}$ , тогда

$$K_{\Pi} = K_{\pi} - \frac{U_{\text{CM1}}}{U_{2}}.$$
 (9)

 $K_{\scriptscriptstyle A}$  — коэффициент детектирования диода  $D_{\scriptscriptstyle 1}$ .

Напряжение  $U_2$  при полной линеаризации пропорционально зазору  $d,\ U_2=Md,\ \mathrm{rge}$ 

М — коэффициент пропорциональности, и выражение (8) запи-

шется

$$i_{K} = i_{Kmin} + NK_{\Pi} M d. \tag{10}$$

Линеаризация статистической характеристики осуществляется соответствующим выбором зависимости сопротивления фильтра нелинейного детектора  $R_{\Phi}$  в функции от зазора  $R_{\Phi} = f(d)$ . Для нахождения этой зависимости приравняем выражения (1), (3) и получим уравнения в неявной форме

$$F(i_{\rm K}, d) = 0.$$
 (11)

Теперь необходимо представить выражение (11) в явном виде:

$$i_{K} = \varphi(d). \tag{12}$$

Если зависимость (12) не выражается через элементарные функции, то преобразование производится графически. Подставляя уравнение (12) в (7) и (10), получаем:

$$R_{\phi} = \psi(d). \tag{13}$$

Эта функция формируется путем подбора сопротивлений  $R_1'$ ,  $R_2'$  ....  $R_n'$ ,  $R_1^{''}$ ,  $R_2^{''}$ , ....  $R_n'$ ,  $R_n^{''}$ ,  $R_2^{''}$ , ....  $R_n'$  и напряжений смещений  $U_{\text{CM1}}$ , ....,  $U_{\text{CM2}}$ . Например,  $R_{\phi 1} = R_1' + R_1''$ ;  $U_{\text{CM1}} < U_2 < U_{\text{CM2}}$ ;

$$R_{\phi 2} = R_1'' \| (R_2' + R_2'') + R_1'; U_{\text{CM2}} < U_2 < U_{\text{CM3}}.$$

При расчете необходимо учитывать, что фильтр  $R_{\phi \max}$   $C_{\phi}$  не будет снижать динамическую точность прибора в том случае, если его постоянная времени

 $\tau_{\Phi} \ll t_{min};$  (14)

 $t_{\min}$  — длительность сигнала, соответствующего межламельному

участку.

При расчете считалось, что постоянное напряжение на коллекторе  $E_{\kappa}$  остается неизменным. Однако в реальной схеме оно изменяется за счет омических сопротивлений в цепи питания транзистора, снижая эффективность АРУ. Поэтому необходимо выбирать  $E_{\kappa}$  достаточно большой величины и уменьшить до минимума сопротивления в цепи питания транзистора.

Все вышеизложенное позволяет предложить следующую методику расчета регулируемого каскада с целью линеаризации статической ха-

рактеристики профилометра:

1. Находим закон регулирования  $K_{\Pi Y}$  согласно выражению (1).

2. Выбираем  $i_{\mathrm{Kmin}}$  и  $i_{\mathrm{Kmax}}$ , определяем  $\sigma = \frac{K_{\mathrm{\Pi y_{max}}}}{K_{\mathrm{\Pi y_{min}}}}$ , где  $K_{\mathrm{\Pi y}}$  оп-

ределяется по формуле (3). Если найденное значение  $\sigma > \frac{K}{f'\left(d_{\max}\right)}$ , то

схема обеспечит линеаризацию характеристики. Если эта величина меньше, то необходимо уменьшить  $d_{\max}$  и производить линеаризацию на меньшем участке.

3. Рассчитываем температурную стабилизацию рабочей точки каскада, исходя из заданного перепада температуры. Величину нестабиль-

ности коллекторного тока определяем по формуле (6) для номинального значения ік.

4. Полученные в результате расчета параметры подставляем в выражение (13). Аппроксимируем полученную зависимость, исходя из заданной точности, и производим расчет фильтра нелинейного детектора.

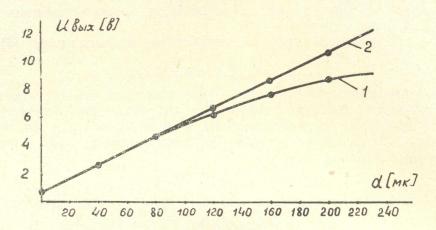


Рис. 4. Статистическая характеристика профилометра: 1 — до линеаризации, 2 — после линеаризации

Разработанная методика расчета регулируемого каскада с цепью АРУ была проверена экспериментально на макете профилометра. В качестве регулируемого каскада был использован резонансный каскад на транзисторе П416Б. Эксперимент показал, что схему АРУ с нелинейным детектором можно с успехом применять, если нелинейность датчика достигает 25-30%. Погрешность расчета составляет около 20% и легко устраняется в процессе настройки профилометра. Результаты испытаний макета представлены на рис. 4.

## ЛИТЕРАТУРА

1. К. Қ. Намитоков, В. Ф. Чепура, В. Г. Брезинский Прибор для исследования динамических изменений формы поверхности коллекторов электрических машин «Электромеханика», 1966, № 1.
2. Н. В. Волошин В. М. Ерухимович, Д. М. Титов. Емкостный элек-

тронный профилометр коллектора «Передовой научно-технический и производственный опыт». № 18—66—1592/129. ГОСИНТИ, М., 1966.

3. В. А. Денисов, В. Е. Шатерников, В. В. Куликов, П. А. Лелеков. Бесконтактный пробник для контроля биений поверхности коллекторов. «Электромеханика», 1970, № 2.

4. И. И. Акулов и др. Радиотехнические схемы на транзисторах и туннельных

диодах, под ред. Р. А. Валитова. «Связь», М. 1966. 5. Ю. Д. Крисилов. Расчет режимной АРУ. «Полупроводниковые приборы и их применение», под ред. Я. А. Федотова, вып. 12, «Советское радио», М., 1964. 6. Н. С. Спиридонов

мости подвижности носителей от концентрации примесей в базе. «Полупроводниковые приборы и их применение», под ред. Я. А. Федотова, вып. 6. «Сов. радио», М., 1960. 7. И. М. Симонтов, В. Д. Иванченко. К расчету АРУ в усилителях на транзисторах. «Полупроводниковые приборы и их применение», под ред. Я. А. Федо-

това вып. 16. «Советское радио», М., 1966.

8. Н. С. Николаенко. Температурная стабилизация и компенсация полупроводниковых усилителей. «Полупроводниковые приборы и их применение», под ред. Я. А. Федотова, вып. 9. «Советское радио», М., 1963.

9. Д. Н. Шапиро. Расчет каскадов транзисторных радиоприемников. «Энер-

гия», 1968.